

OTP_Writer (Ver.C) 與 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 之擴充修改

內容： OTP_Writer (Ver.C) 與 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 的電路板須做擴充修改以支援未來新的 Nyquest OTP IC。

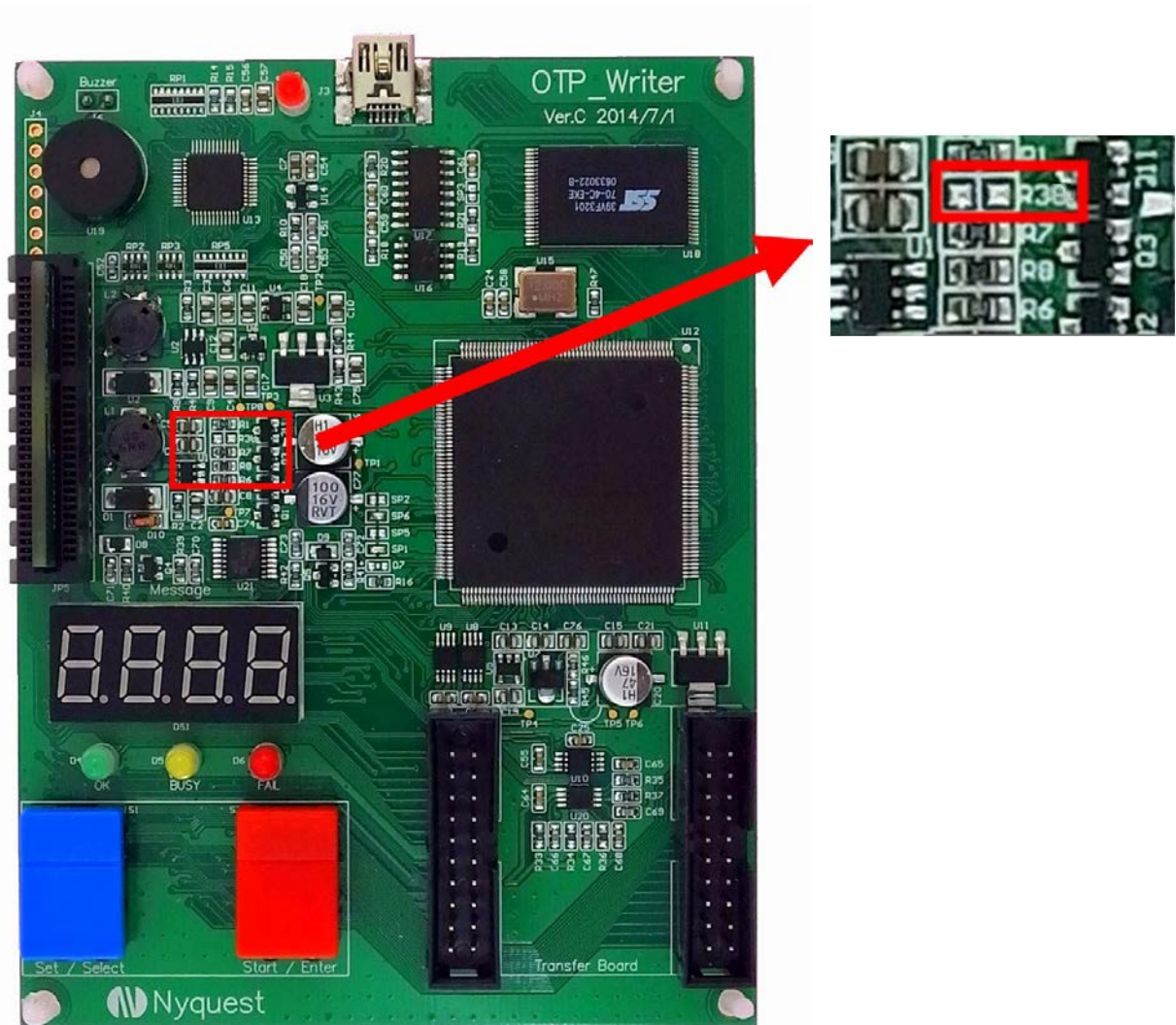
原因： 為支援未來更多新產品 OTP IC 的燒錄電壓，OTP_Writer (Ver.C) 與 NY8-OTP_Writer (Ver.A) 必須做擴充修改，以因應未來 OTP 燒錄的需求。

方法： 請使用者依下述步驟自行修改：

1. OTP_Writer (Ver.C) 電路板修改方式

將 R38 增加焊接 18KΩ +/-1% 電阻。

OTP_Writer (Ver.C) 電路板 R38 位置如下圖：



2. NY8-OTP_Writer (Ver.A) 電路板修改方式

- A. 將 R33 增加焊接 22KΩ +/-1% 電阻。
- B. 將 R34 增加焊接 1.5KΩ +/-1% 電阻。

NY8-OTP_Writer (Ver.A) 電路板 R33 與 R34 位置如下圖：

